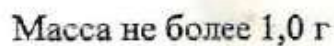


Кремниевые эпитаксиально-планарные высокочастотные п-р-п транзисторы КТ972А, КТ972Б, КТ972В, КТ972Г большой мощности, выполненные в пластмассовом корпусе и предназначенные для использования в выходных каскадах систем автоматики



Основные электрические параметры при $T_{\text{ср}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектор- эмиттер, мА $R_{ЕЭ} = 1 \text{ кОм}$	$I_{КЭР}$		
$U_{КЭ} = 60 \text{ В}$ КТ972А, КТ972В		-	1,0
$U_{КЭ} = 45 \text{ В}$ КТ972Б		-	1,0
$U_{КЭ} = 60 \text{ В}$ КТ972Г		-	0,3
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером	$h_{21э}$		
$U_{КБ} = 3 \text{ В}, I_Э = 1000 \text{ мА}, f = 50 \text{ Гц}$	КТ972А, КТ972Б	750	-
	КТ972В, КТ972Г	750	5000
$U_{КБ} = 10 \text{ В}, I_Э = 500 \text{ мА}, f = 50 \text{ Гц}$	КТ972А	2000	-
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ \text{ нас}}$		
$I_K = 500 \text{ мА}, I_E = 50 \text{ мА}$	КТ972А, КТ972Б, КТ972В	-	1,5
	КТ972Г	-	0,95
$I_K = 500 \text{ мА}, I_E = 0,5 \text{ мА}$	КТ972А	-	1,3
Напряжение насыщения база-эмиттер, В	$U_{БЭ \text{ нас}}$		
$I_K = 500 \text{ мА}, I_E = 50 \text{ мА}$	КТ972А, КТ972Б, КТ972В	-	2,5
	КТ972Г	-	1,7
$I_K = 500 \text{ мА}, I_E = 0,5 \text{ мА}$	КТ972А	-	1,9

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт.
ТРАНЗИСТОРОВ:

Золото 0,2783 г; Серебро 2,1506 г.

Драгоценные металлы на выводах не содержатся

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ972А, КТ972Б, КТ972В, КТ972Г соответствуют техническим условиям АО.336.452 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
дата

Место для штампа ОТК

OTK 184